

05;12
 ©1993 г.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА, ТОЛЩИНЫ
 И ОЦЕНКА НЕОДНОРОДНОСТИ СОСТАВА ПО ТОЛЩИНЕ
 СУБМИКРОННЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ $Y_1Ba_2Cu_3O_y$
 МЕТОДОМ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО МИКРОАНАЛИЗА**

B.V. Третьяков, С.Г. Конников, О.В. Корнякова

Наибольший интерес в области ВТСП материалов вызывает соединение $Y_1Ba_2Cu_3O_y$. Этот материал обладает сильно выраженной гетерогенностью, для пленок на его основе характерной является неоднородность состава как по площади, так и по толщине. Неоднородность по толщине ВТСП пленок — это результат нестационарного во времени процесса формирования пленки, взаимодействия с подложкой либо послеростовой обработки. Изучение этих неоднородностей позволяет понять процессы формирования структуры, оптимизировать технологические режимы.

Среди большого числа аналитических методов, используемых для определения элементарного и фазового состава, активно применяется рентгеноспектральный микроанализ (РСМА). Однако аналитические возможности метода применительно к исследованию ВТСП материалов до настоящего времени не изучены. Работа посвящена описанию разработанной нами методики расчета состава, толщины и оценке неоднородности состава по толщине в субмикронных пленках $Y_1Ba_2Cu_3O_y$. Как известно, метод основан на измерении интенсивности характеристического рентгеновского излучения (k -отношения), возбуждаемого сфокусированным электронным пучком с энергией E_0 , относительно эталона и расчета состава на основе учета механизмов рассеяния электронов, генерации и поглощения рентгеновского излучения. Сравнительно недавно этот расчет стал производиться с учетом функции распределения генерации рентгеновского излучения по глубине (ФРГИ), что значительно расширило диапазон рабочих ускоряющих напряжений E_0 , возросла правильность анализа. Проведение серии измерений при разных ускоряющих напряжениях позволяет получать данные при разной глубине возбуждения [1,2]. Зная изменение глубины выхода рентгеновского излучения и вклад определенного слоя образца, можно дать оценку однородности распределения состава по глубине. Воспроизводимость и достоверность анализа соединений с большим числом компонент требуют минимизации числа используемых ускоряющих напряжений. Анализ ФРГИ показал, что для

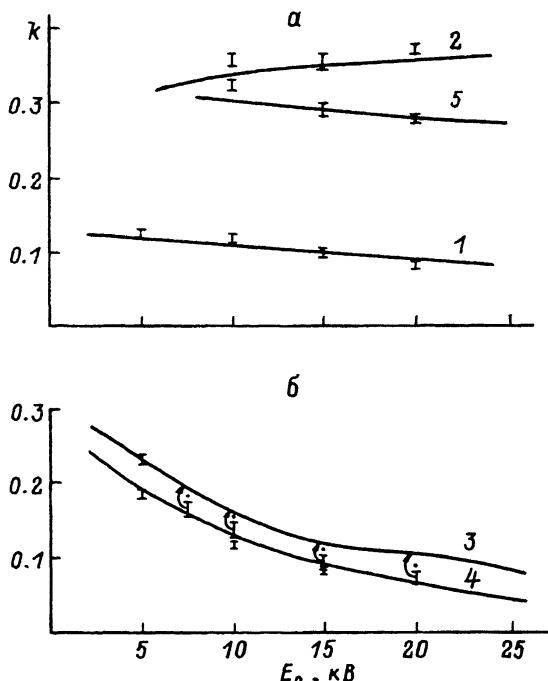


Рис. 1. Зависимость k -отношений от ускоряющего напряжения E_0 для кристаллов $\text{Y}_1\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.8}$ для линий $\text{Y } L_\alpha$ (1), $\text{Ba } L_\alpha$ (2), $\text{Cu } L_\alpha$ (3), $\text{O } K_\alpha$ (4), $\text{Cu } K_\alpha$.

Угол выхода 40° , сплошная линия — расчет по методу [3].

определения однородности состава достаточно произвести несколько измерений при известной продольной локальности. По совпадению расчетных и измеренных k -отношений образца с расчетным составом можно косвенно судить о правильности поведения ФРГИ для низких ускоряющих напряжений. Таким образом, необходимо исследовать правильность анализа в зависимости от E_0 и определить реальную с учетом поглощения продольную локальность анализа.

Для проведения изменений использовался рентгеновский микроанализатор Семевах-місцевейм с энергодисперсионным анализатором Edax-9900. Кислород измерялся с помощью W/Si многослойного кристалла с межплоскостным расстоянием 60 \AA .

Правильность анализа оценивалась путем сравнения расчетных k -отношений по методике [3], соответствующих составу $\text{Y}_1\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.8}$ и экспериментально измеренных на специально отобранных кристаллах $\text{Y}_1\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ с $T_c = 85 - 90 \text{ K}$ (определялась методом ЭПР). Полученные результаты измерений представлены на рис. 1, а, б. Видно что зависимость k -отношений представляет слабую функцию от E_0 , следовательно, необходима высокая точность измерений. В результате измерений установлено, что случайная ошибка может быть доведена до 2–3 отн.%, однако систематическая находится в пределах 10 отн.%. Влияние ускоряющего напряжения на статистическую и систематическую ошибку измерений, а также на расхождение в расчете состава будет исследовано дополнительно. Продольная локальность анализа определялась по кривым доли выходящего рентгеновского излучения от глубины с учетом поглощения и ФРГИ, определенной в [3]. На рис. 2, а–в приведены кривые для ускоряющих напряжений 5, 10, 15 кВ. Совместное рассмотрение рис. 1 и 2 дают следующую таблицу.

Ускоряющее напряжение, кВ	Локальность по всем элементам, мк	Ошибка введения поправки не превышает 10%				
		$Y l_\alpha$	$Ba L_\alpha$	$Cu L_\alpha$	$Cu k_\alpha$	$O k_\alpha$
5	0.12	да	нет	да	нет	да
10	0.4	да	да	нет	нет	да
15	0.9	да	да	нет	да	да

Из таблицы видно, что 15 кВ — минимальное ускоряющее напряжение, при котором поправки для всех четырех элементов рассчитываются с точностью лучшей, чем 10%. Локальность анализа при напряжениях 5 (а), 10 (б), 15 кВ (в) перекрывает весь диапазон получаемых толщин ВТСП пленок, и для толщин 0.2–1.0 мк имеется возможность оценки неоднородности по составу и толщине пленки. Проблема расчета состава при 10 и 5 кВ (для $Cu L_\alpha$) может быть отчасти решена путем использования для расчета соединения $Y_1Ba_2Cu_3O_{6.8}$. В таком случае можем

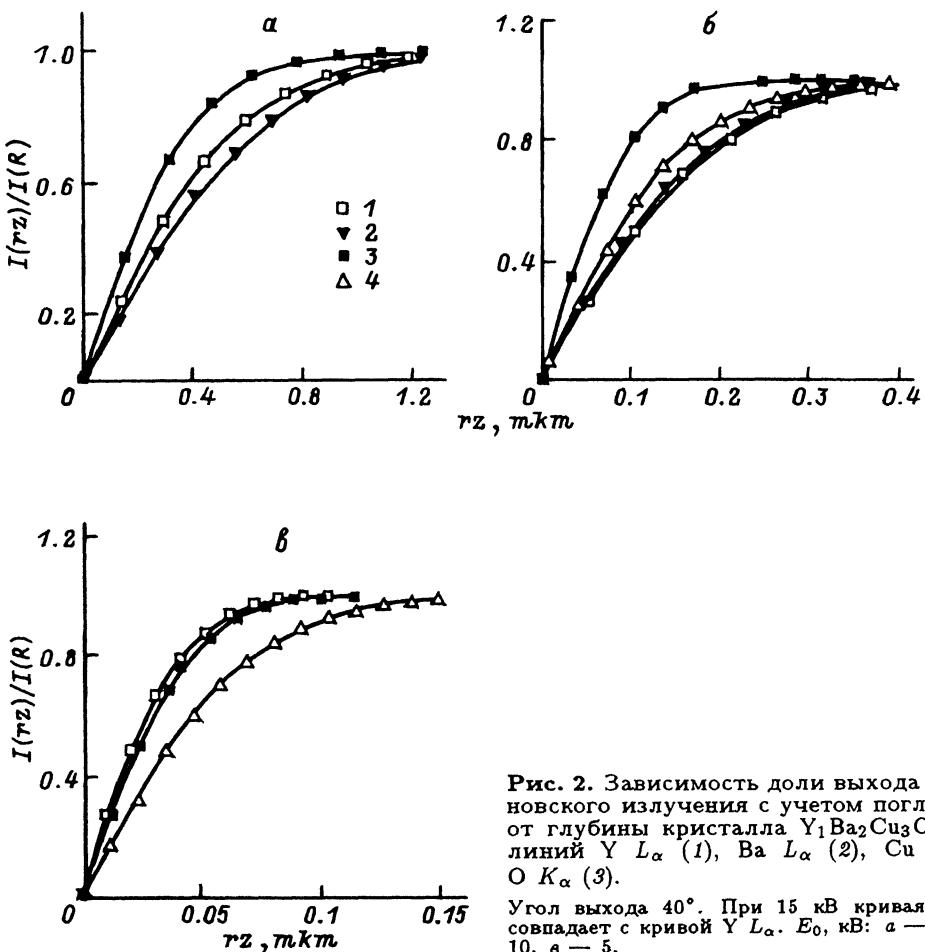


Рис. 2. Зависимость доли выхода рентгеновского излучения с учетом поглощения от глубины кристалла $Y_1Ba_2Cu_3O_{6.8}$ для линий $Y L_\alpha$ (1), $Ba L_\alpha$ (2), $Cu L_\alpha$ (4), $O K_\alpha$ (3).

Угол выхода 40° . При 15 кВ кривая $Cu K_\alpha$ совпадает с кривой $Y L_\alpha$. E_0 , кВ: а — 15, б — 10, в — 5.

использовать компенсацию ошибок введения поправок, выражение для расчета поправки можно представить в следующем виде:

$$\begin{aligned}
 k_{ybaco} &= \frac{C_{ybaco}}{C_{ybco}} \frac{\int_0^{\infty} F_{cu}^{ybaco}(rz) \exp(-\chi_{ybaco} \cdot rz) drz}{\int_0^{\infty} F_{cu}^{ybco}(rz) \exp(-\chi_{ybco} \cdot rz) drz} = \frac{C_{ybaco}}{C_{ybco}} \times \\
 &\times \frac{\int_0^{\infty} F_{cu}^{ybaco}(rz) \exp(-\chi_{ybaco} \cdot rz) drz \int_0^{\infty} F_{cu}^{cu}(rz) \exp(-\chi_{cu} \cdot rz) drz}{\int_0^{\infty} F_{cu}^{cu}(rz) \exp(-\chi_{cu} \cdot rz) drz \cdot \int_0^{\infty} F_{cu}^{ybco}(rz) \exp(-\chi_{ybco} \cdot rz) drz} = \\
 &= \frac{C_{ybaco}}{C_{ybco}} \cdot f(ybaco) \cdot f(ybco).
 \end{aligned}$$

где $F_{cu}^{ybaco}(rz)$ — ФРГИ для исследуемого соединения для элемента Cu, rz — массовая толщина, C_{ybaco} — его весовая концентрация, $F_{cu}^{ybco}(rz)$ — ФРГИ для $\text{Y}_1\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.8}$ соединения, C_{ybco} — его весовая концентрация, $F_{cu}^{cu}(rz)$ — ФРГИ для чистого элемента, $\exp(-\chi_{ybaco} \cdot rz)$ — учет поглощения генерируемого излучения.

Зависимость $f(ybaco)$ и $f(ybco)$ от состава и поглощения в общем случае различная, поэтому полной компенсации ошибок введения поправок не происходит, но наши оценки показывают, что ошибка не должна превышать 10 отн.%. Для однородных пленок с толщиной больше 0.4 мк возможна проверка расчета состава при ускоряющем напряжении 15 кВ по линии Cu K_{α} . Продольная локальность при этом напряжении больше толщины пленки, в этом случае возможно использовать разработанную нами методику одновременного определения состава и толщины [4]. Для проверки данной методики применительно к материалам ВТСП было проведено сопоставление с результатами РОР, оно показало совпадение результатов в пределах 15%. Рассчитываемый при разных ускоряющих напряжениях состав и толщина совпадают друг с другом с точностью до 10%. Многие однородные пленки, с $T_c = 88-90$ К, имеют рассчитываемый состав, близкий к $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$, встречаются также составы с отклонением от стехиометрии. В том случае, когда поверхность ВТСП пленки обладает развитым рельефом, сходимость результатов может увеличиваться до 5-10%. Таким образом, серия измерений при более низких напряжениях путем сравнения с кристаллами $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ позволяет оценить однородность распределения состава по глубине. В качестве примера реализации разработанной методики по оценке однородности состава можно привести следующие измерения. Исходная пленка, полученная методом магнетронного напыления в режиме *in situ* на подложке SrTiO_3 с ориентацией 110, с послеростовой обработкой в атмосфере O_2 ($T_{обр} = 450^\circ \text{C}$, $t_{выд} = 1$ ч) была разделена на 4 части, три из которых были подвергнуты при температуре 550°C в течение часа при различном давлении кислорода дополнительной обработке: пленка 2 (0.1 Тор), пленка 1 (1 Тор), пленка 4 (100 Тор), исходная пленка — пленка 3. РСМА измерения были проведены при 5, 10, 15 кВ. На рис. 3 представлены величины k -отношений от пленки, приведенные к k -отношениям ВТСП

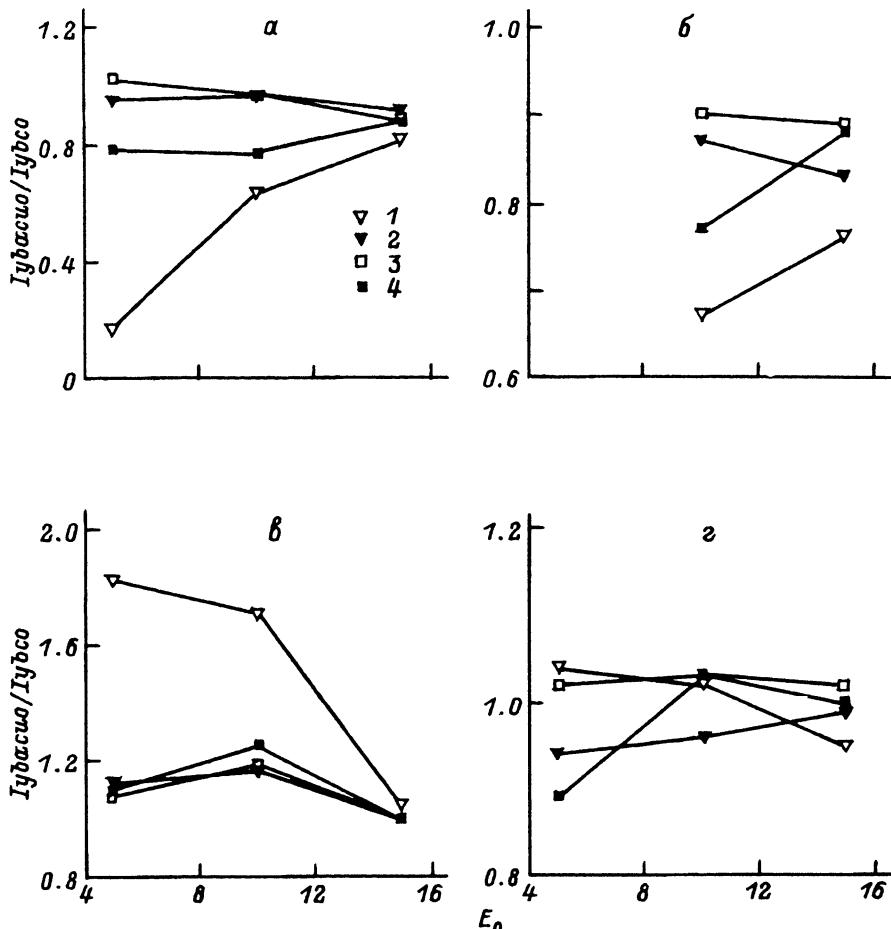


Рис. 3. Зависимости k -отношений с пленки к k -отношениям кристалла $Y_1Ba_2Cu_3O_{6.8}$ для линий $Y L_\alpha$ (а), $Ba L_\alpha$ (б), $Cu L_\alpha$ (в), $O K_\alpha$ (г).

Угол выхода 40° . 1-4 — образцы 1-4 соответственно.

криSTALLов. Из данных при 15 кВ ясно, что толщина пленки меньше продольной локальности, по методике [4] находим толщину и состав исходной пленки, он равен $YBa_{2.0}Cu_{3.3}O_7$ при толщине 0.45–0.5 мк (для плотности принималось значение 6 г/см³). Однако по данным при 5 кВ (без учета Ba, чья линия не возбуждается при этой энергии) состав соответствует $YBa_2Cu_3O_7$, а данные при 10 кВ — составу с повышенным Cu. Можно заключить, что при послеростовой обработке исходной пленки на ее поверхности образовался слой состава $YBa_2Cu_3O_7$ около 0.1 мк толщиной при общем повышенном содержании Cu в пленке. Пленка 2 имеет меньшее содержание по O и Y. В пленке 4 поверхностная концентрация Y еще меньше, а концентрация Cu возросла. В пленке 1 в поверхностном слое Y почти нет, сильно уменьшен Ba. Можно заключить, что при обработке происходит термическая диссоциация. На поверхности образуется ряд сложных окислов, Y в виде оксида собирается в микровключения, сложные окислы продолжают диссоциировать до выделения окислов на осно-

ве CuO. Усредненный рассчитанный состав в поверхностном слое пленки 1 соответствует $Y_{0.1}Ba_1Cu_{2.9}O_{3.6}$ при толщине до 0.1 мк, а пленки 4 — $Y_1Ba_3Cu_4O_7$. Изменение состава в пленке 4 подтверждает появление катодолюминесценции, в пленке 1 катодолюминесценция меняет цвет.

Заключение

Проведена экспериментальная проверка рабочего диапазона используемых ускоряющих напряжений при расчете состава $Y_1Ba_2Cu_3O_y$ соединений. Разработана локальная методика оценки неоднородности состава по глубине субмикронных пленок.

Данная работа выполнена в рамках проекта № 803 (Диагностика ВТСП материалов).

Список литературы

- [1] Дорохов А.Н., Рояк А.Я., Мазалов Л.Н. и др. // Изв. СО АН СССР. Сер. Хим. 1980. Т. 2. № 1. С. 135–137.
- [2] Гимельфарб Ф.А. Рентгеноспектральный микроанализ слоистых материалов. М.: Металлургия, 1986.
- [3] Pouchois J.L., Pichoir F. // Rech. Aerosp. 1984. Vol. 3. P. 13–39.
- [4] Казаков С.В., Конников С.Г., Третьяков В.В. // Изв. АН СССР. 1991. Т. 55. № 8.

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
13 апреля 1993 г.